



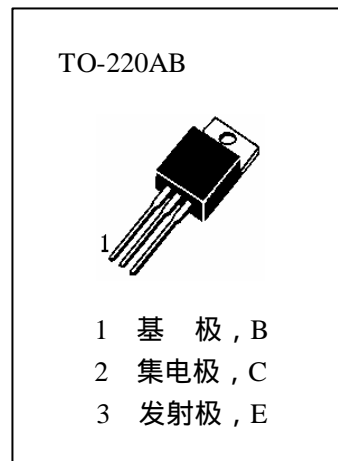
**主要用途**

高压快速开关

**外形图及引脚排列**

**极限值 (  $T_a=25$  )**

$T_{stg}$	— 贮存温度.....	-65~150
$T_j$	— 结温.....	150
$P_C$	— 集电极功率耗散( $T_c=25$ ).....	80W
$V_{CBO}$	— 集电极—基极电压.....	700V
$V_{CEO}$	— 集电极—发射极电压.....	400V
$V_{EBO}$	— 发射极—基极电压.....	9V
$I_C$	— 集电极电流( DC ).....	8A
$I_C$	— 集电极电流( 脉冲 ).....	16A
$I_B$	— 基极电流.....	4A



**电参数 (  $T_a=25$  )**

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
$BV_{CEO}$	集电极—发射极击穿电压	400			V	$I_C=10mA, I_B=0$
$I_{EBO}$	发射极—基极截止电流			1	mA	$V_{EB}=9V, I_C=0$
$H_{FE}(1)$	直流电流增益	10		40		$V_{CE}=5V, I_C=2A$
$H_{FE}(2)$		5		30		$V_{CE}=5V, I_C=5A$
$V_{CE}(sat1)$	集电极—发射极饱和电压			1	V	$I_C=2A, I_B=0.4A$
$V_{CE}(sat2)$				2	V	$I_C=5A, I_B=1A$
$V_{CE}(sat3)$				3	V	$I_C=8A, I_B=2A$
$V_{BE}(sat1)$	基极—发射极饱和电压			1.2	V	$I_C=2A, I_B=0.4A$
$V_{BE}(sat2)$				1.6	V	$I_C=5A, I_B=1A$
$C_{ob}$	共基极输出电容		110		pF	$V_{CB}=10V, f=0.1MHz$
$f_T$	特征频率	4			MHz	$V_{CE}=10V, I_C=0.5A$
$t_{on}$	导通时间			1.6	$\mu S$	} $V_{CC}=125V, I_C=5A$ $I_{B1}=-I_{B2}=1A$
$t_{stg}$	贮存时间			3	$\mu S$	
$t_f$	下降时间			0.7	$\mu S$	

分档 : H1( 10--16 ) H2( 14--21 ) H3( 19--26 ) H4( 24--31 ) H5( 29--40 )



特性曲线

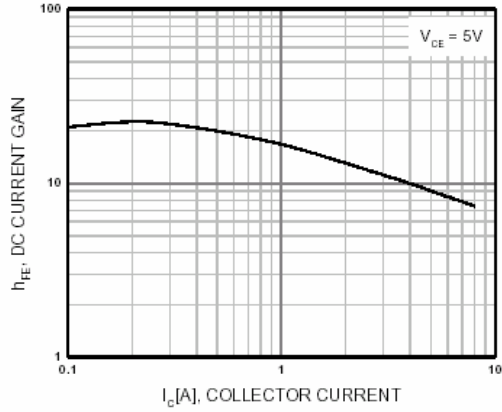


Figure 1. DC current Gain

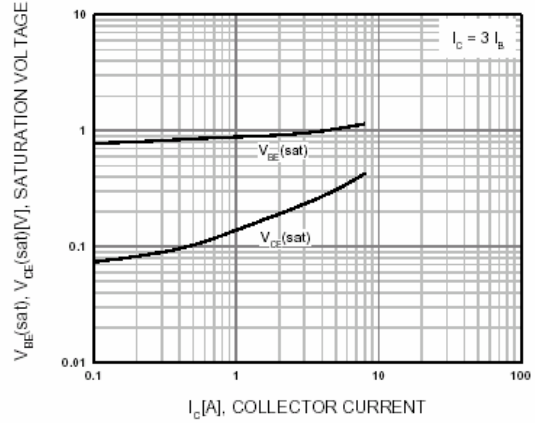


Figure 2. Base-Emitter Saturation Voltage  
Collector-Emitter Saturation Voltage

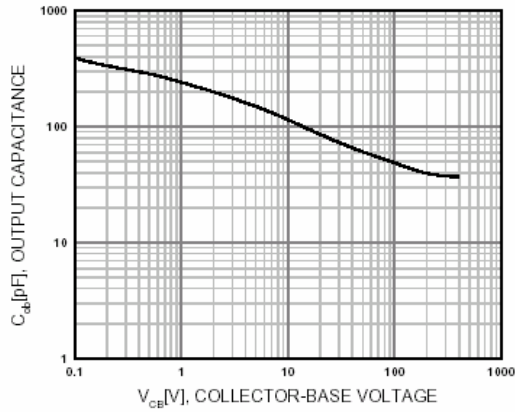


Figure 3. Collector Output Capacitance

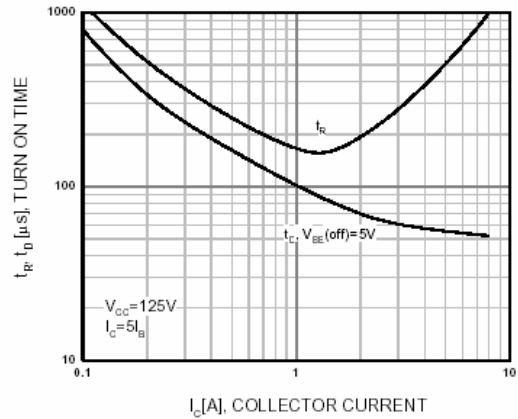


Figure 4. Turn On Time

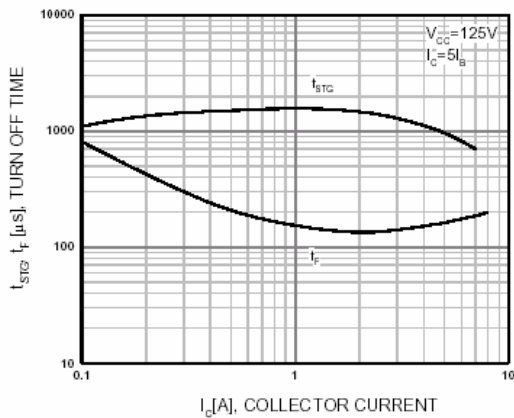


Figure 5. Turn Off Time

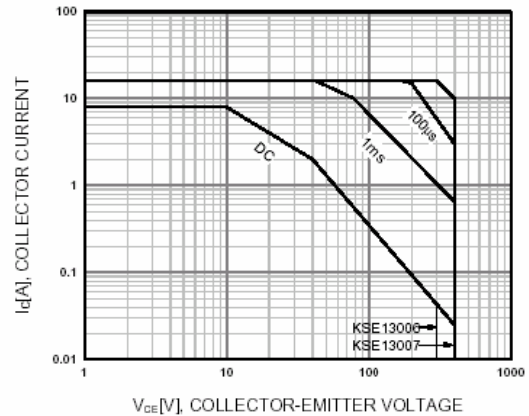


Figure 6. Safe Operating Area



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

**HE13007**

对应国外型号  
KSE13007

## 特性曲线

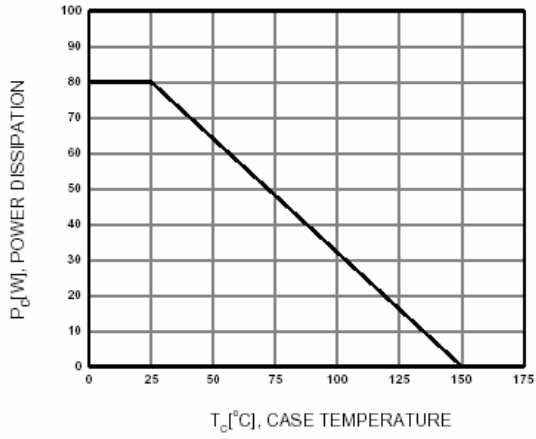


Figure 7. Power Derating